

关于团体标准 T/CASAS 037 《SiC MOSFET 栅极电荷测试方法》等 十一项标准立项的通知

各联盟成员单位：

按照 CASAS 相关管理办法，经管理委员会投票，第三代半导体产业技术创新战略联盟标准化委员会（CASAS）通过 11 项 SiC MOSFET 测试方面的团体标准立项建议，并分配标准编号如下：

1、T/CASAS 037—20XX 《SiC MOSFET 栅极电荷测试方法》

牵头单位：东南大学

联合单位：工业和信息化部电子第五研究所、苏州汇川联合动力系统股份有限公司、智新半导体有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、芯联集成电路制造股份有限公司、复旦大学宁波研究院

2、T/CASAS 038—20XX 《SiC MOSFET 非钳位电感开关（UIS）测试方法》、T/CASAS 039—20XX 《SiC MOSFET 单管功率器件短路可靠性测试方法》、T/CASAS 040—20XX 《SiC MOSFET 功率模块短路可靠性测试方法》

牵头单位：北京华峰测控技术股份有限公司

联合单位：工业和信息化部电子第五研究所、东南大学、智新半导体有限公司、江苏易矽科技有限公司、华润微电子封测事业群、宁波达新半导体有限公司、杭州飞仕得科技股份有限公司



3、T/CASAS 041—20XX 《基于无功负载的车规级功率模块变频测试规范》

牵头单位：智新半导体有限公司

联合单位：株洲中车时代半导体有限公司、湖北九峰山实验室、重庆大学、山东阅芯电子科技有限公司、上海瞻芯电子科技有限公司、化合积电(厦门)半导体科技有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、深圳市原力创造科技有限公司、东风汽车研发总院、智新科技股份有限公司、中国第一汽车集团有限公司研发总院、武汉大学

4、T/CASAS 042—20XX 《SiC MOSFET 高温栅偏试验方法》、T/CASAS 043—20XX 《SiC MOSFET 高温反偏试验方法》、T/CASAS 044—20XX 《SiC MOSFET 高温高湿反偏试验方法》

牵头单位：忱芯科技（上海）有限公司

联合单位：工业和信息化部电子第五研究所、湖北九峰山实验室、中国科学院微电子研究所、复旦大学、广电计量检测集团股份有限公司、芯联集成电路制造股份有限公司、安徽长飞先进半导体有限公司、东北电力大学、吉林省特种设备监督检验中心

5、T/CASAS 045—20XX 《SiC MOSFET 动态栅偏试验方法》

牵头单位：复旦大学宁波研究院、复旦大学

联合单位：清纯半导体（宁波）有限公司、工业和信息化部电子第五



研究所、重庆大学、杭州三海电子科技股份有限公司、中国科学院微电子研究所、深圳市禾望电气股份有限公司、智新半导体有限公司、常州银河世纪微电子股份有限公司

6、T/CASAS 046—20XX 《SiC MOSFET 动态反偏(DRB)试验方法》、
T/CASAS 047—20XX 《SiC MOSFET 动态高温高湿反偏(DH3RB)试验方法》

牵头单位：工业和信息化部电子第五研究所

联合单位：忱芯科技（上海）有限公司、中国科学院电工研究所、比亚迪半导体股份有限公司、复旦大学宁波研究院

特此通知。

北京第三代半导体产业技术创新战略联盟

2024年1月26日

